

Скачков Александр Федорович, кандидат технических наук, АО «Сатурн» (г. Краснодар), заместитель генерального директора по научной работе.

Список основных публикаций:

[1] Скачков, А.Ф. Оптимизация структуры трёхпереходного солнечного элемента GaInP/GaAs/Ge со встроенным брэгговским отражателем $Al_{0,1}Ga_{0,9}As / Al_{0,8}Ga_{0,2}As$ = Optimization of the structure of a GaInP/GaAs/Ge triple-junction solar cell with an $Al_{0,1}Ga_{0,9}As / Al_{0,8}Ga_{0,2}As$ integrated Bragg reflector / А.Ф. Скачков // Автометрия. – 2014. – Т. 50. – №4. – С. 122-126 [Optoelectronics, Instr. and Data Proc. – 2014. – Т. 50. – №4. – P. 423-427 (DOI: 10.3103/S8756699014040165)]

[2] Скачков, А.Ф. Полупроводниковые соединения GaInP, легированные изовалентной примесью Sb = GaInP semiconductor compounds doped with the Sb isovalent impurity / А.Ф. Скачков // Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – №5. – С. 593-595 [Semiconductors. – 2015. – Т. 49. – №5. – P. 579-581 (DOI: 10.1134/S1063782615050231)]

[3] М.А. Пулято, Н.А. Валишева, В.В. Преображенский, И.Б. Чистохин, Б.Р. Семягин, Е.А. Емельянов, А.В. Васев, А.Ф. Скачков, Г.И. Юрко, И.И. Нестеренко, М.О. Петрушков, Легкий гибкий солнечный элемент на основе гетероэпитаксиальной структуры InGaP/GaAs // Журнал технической физики. – 2019. – Т. 89. – №7. – С. 1071-1078 [A lightweight flexible solar cell based on a heteroepitaxial InGaP/GaAs structure // Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics. – 2019. – Т. 64. – №7. – P. 1010-1016 (DOI: 10.1134/S106378421907020X)]

[4] V. T. Panyushkin, A. A. Nikolaev, A. F. Skachkov, D. S. Sklyarov, and M. E. Sokolova Light conversion properties of thin films based on terbium(iii) 2-phenyloxybenzoate // Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 86, No. 5, November, 2019 (Russian Original Vol. 86, No. 5, September–October, 2019), DOI 10.1007/s10812-019-00914-1

[5] Е.Н. Тумаев, А.Ф. Скачков, Легирование эпитаксиальных слоев $Ga_xIn_{(x-1)}P_ySb_{(y-1)}$ примесью теллура // Политематический сетевой эл. научный журнал КубГАУ. – 2014. – №102. – С. 726-734. – URL: <http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/045.pdf>

- [6] Скачков, А.Ф. Разработка технологии производства многопереходных солнечных элементов с повышенной радиационной стойкостью. Достигнутый уровень ВАХ солнечных элементов / А.Ф. Скачков // Автономная энергетика: технический прогресс и экономика. – 2014. – № 32. – С. 10-13 (0,47).
- [7]. Богатов, Н.М. О проблемах создания четырехкаскадных солнечных элементов с согласованной кристаллической решеткой / Н.М. Богатов, А.Ф. Скачков, И.И. Нестеренко // Экологический вестник научных центров ЧЭС. – 2017. – Т.14. – №4-1. – С. 74-80 (0,41/0,33).
- [8] Скачков, А.Ф. Производство космических гетероструктурных солнечных элементов ПАО “Сатурн” / А.Ф. Скачков, В.В. Касаткин, Г.И. Юрко, И.И. Нестеренко // Физико-химические проблемы возобновляемой энергетики: материалы рос. конф. (Санкт-Петербург, 21-23 ноября 2016 г.). – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2016. – С. 164 (0,06/0,03).
- [9]. Путятю, М.А. Гибкие солнечные элементы на основе гетероэпитаксиальных структур соединений АІІІВV / М.А. Путятю, Н.А. Валишева, В.В. Преображенский, И.Б. Чистохин, Б.Р. Семягин, Е.А. Емельянов, А.В. Васев, А.Ф. Скачков, Г.И. Юрко, И.И. Нестеренко, С.В. Янчур // Физика полупроводников и наноструктур, полупроводниковая опто- и наноэлектроника: материалы всерос. мол. конф. (Санкт-Петербург, 26-30 ноября 2018 г.). – Санкт-Петербург: Изд-во Политех-Пресс, 2018. – С. 21 (0,06/0,01)
- [10]. Skachkov, A.F. About the results of developing GaInP/GaAs/Ge triplejunction solar cell epitaxial structures with an average efficiency of 29.5% / A.F. Skachkov, I.I. Nesterenko, L.N. Skachkova, // Авиация и космонавтика - 2019: материалы междунар. конф. (Москва, 18-22 ноября 2019 г.). – Москва: Изд-во МАИ, 2019. – С. 379-380 (0,12/0,1).